# レーザー生成プラズマにおける レイリー・テイラー不安定性

### 境家 達弘

大阪大学レーザーエネルギー学研究センター



アウトライン



- 1. 背景&目的
- ・レーザー核融合
  ・レイリー・テイラー不安定性
  ・レイリー・テイラー不安定性研究の現状
  2. レイリー・テイラー不安定性の観測
  ・観測手法、モアレ干渉法
  ・分散関係
  ・分散関係
  ・分散関係

・カット・オフ面の変調

・レーザー収束の効果

4. まとめ

1. レーザー核融合

## レーザー核融合では、高温・高密度爆縮が必要

### **D-T** reaction

$$D+T \rightarrow ^{4}He(3.52MeV) + n(14.06MeV)$$

高温(温度>5keV),高密度(固体密度の1000倍程度)が必要



1. レイリー・テイラー不安定性

レイリー・テイラー不安定性が高密度爆縮を妨げる。



初期にターゲット表面に存在する微小擾乱、あるいはレーザーのインプリントを種に、 その界面でレイリー・ティラー不安定性が成長する.

### 古典的なレイリー・テイラー(RT)不安定性



1. 安定化機構

# レーザー生成プラズマにおけるレイリー・テイラー不安定性



1. 研究目的

レイリー・テイラー不安定性の理論式の検証



実験結果は、シミュレーション結果と比較されている。

◎計測の分解能の制限により、短波長擾乱(~10 μm)の成長観測は困難 ほとんどの実験は、擾乱波長が 20 μm よりも大きいところでRT成長を観測。

◆実験と理論(シミュレーション)を比較し、理論式の検証を行う

- 1. 分散関係を計測:特に短波長領域(~10μm以下)
- 係数βの実験的評価

### 2. RT不安定性の観測

ドライブレーザーによって加速されたターゲットをX線で照明し、 その透過X線のコントラストの時間変化を観測する。



#### 2. モアレ干渉法

# モアレ干渉法は、計測の分解能以下である 短波長擾乱(波長12µm以下)の計測を可能にする。



#### 2. 実験配置図

# モアレ干渉法を使ったレイリー・テイラー不安定性観測



2. 実験結果

モアレ干渉法を用いたレイリー・テイラー不安定性の観測結果及び解析



時間の初期には見られないような 擾乱が、時間とともに成長している。 (コントラストがよくなっている。) 強度分布のコントラストから 擾乱振幅を求める。

擾乱振幅: 
$$oldsymbol{a}=oldsymbol{a}_{0}oldsymbol{e}^{\prime t}$$

擾乱振幅は、時間に対して 指数関数で成長する。 この時間発展を指数関数で フィッティングしたときの 傾きが成長率 γである。 2. 分散関係

# 2つのレーザー条件でレイリー・テイラー不安定性の観測を行った。

構成1		構成2
<mark>加速用レーザー(PCL)</mark> 強度(W/cm <sup>2</sup> ) 波長(µm) パルス幅(ns)	7 ×10 <sup>13</sup> 0. 53 2. 3	初期圧縮用レーザー(PCL) 強度(W/cm <sup>2</sup> ) ~ 1 × 10 <sup>12</sup> 波長(µm) 0. 53 パルス幅(ns) 2. 3 加速用レーザー(SSD)
パルス波形 Ŷuz 1 ↑ main ist (PCL)		強度(W/cm <sup>2</sup> ) ~ 1 × 10 <sup>14</sup> 波長(μm) 0. 35 パルス幅(ns) 2. 5 パルス波形
2.3ns 0 Time [ns]		Taser intensity (SSD) foot (PCL) 2.5ns
		2.010 0 Time [ns]

Time [ns]

2. 分散関係

# 中波長領域 (λ = 30-120 μm) において、 レイリー・テイラー不安定性の成長率は予測値よりも小さい。

レーザー波長 : **0.53** μm





2. βの決定

### すべてのパラメーターを計測して、係数βを評価する

RT成長抑制の係数βを実験的に評価することが最重要!

RT不安定性成長率  

$$\gamma = \sqrt{\frac{kg}{1+kL}} - \beta kv_a$$
  $v_a = \frac{\dot{m}}{\rho_a}$ 

g:加速度, L:密度スケール長,  $v_a$ :アブレーション速度,  $\dot{m}$ :質量噴出率,  $ho_a$ :密度

これまで、

計測器の分解能の制限により、ターゲットの密度分布( $\rho_a$ , L)を測ることは困難であった。

しかし最近、

高空間分解能の計測手法が開発され、密度計測が可能になった。

すべてのパラメーターを計測して、係数 $\beta$ を評価する

# $\gamma = [kg/(1+kL)]^{1/2} - \beta km/\rho_a$

密度分布\*



レーザー強度: フットパルス:2 ×10<sup>12</sup> W/cm<sup>2</sup> メインパルス:0.8 ×10<sup>14</sup> W/cm<sup>2</sup> ターゲット: CH 40 µm<sup>t</sup> + AI 500 Å



\* Fujioka, S., et al. (2003), Phys. Plasmas 10, 4784,

2. 加速度の観測:g

 $\gamma = [kg/(1+kL)]^{1/2} - \beta km/\rho_a$ 



#### 2. 質量噴出率の観測: m

# $\gamma = [kg/(1+kL)]^{1/2} - \beta km/\rho_a$



### 2. RT不安定性の観測:γ

# $\gamma = [kg/(1+kL)]^{1/2} - \beta km/\rho_a$

成長率



Laser intensity : Foot-pulse :  $2 \times 10^{12}$  W/cm<sup>2</sup> Main-pulse :  $1.2 \times 10^{14}$  W/cm<sup>2</sup> Target : CH 40  $\mu$ m<sup>t</sup> + Al 500 Å



Laser intensity : Foot-pulse :  $3 \times 10^{12}$  W/cm<sup>2</sup> Main-pulse :  $0.7 \times 10^{14}$  W/cm<sup>2</sup> Target : CH 40  $\mu$ m<sup>t</sup> + Al 500 Å

### 2. RT不安定性の観測:γ



2. β決定

# 係数βを実験的に評価

RT不安定性成長率  
$$\gamma = \sqrt{\frac{kg}{1+kL}} - \beta k v_a$$

Betti *et al*. (1998);

for plastic (CH) target

For  $\lambda = 20 \ \mu m$ 

$$\beta = 2.0^{+1.8}_{-1.0}$$

For  $\lambda = 50 \ \mu m$ 

$$\beta = 4.8^{+2.3}_{-1.6}$$

2. 分散関係

RT抑制の係数βは、波長依存性を持っている

レーザー波長: **0.53** μm ーザー波長:<mark>0.35</mark> μm :Experiment :Experiment 3 3 ٠  $:\beta = 2.0$  $:\beta = 2.0$  $:\beta = 4.8$  $:\beta = 4.8$ Growth rate (ns<sup>-1</sup>) Growth rate (ns<sup>-1</sup>) 2 2 1 0 0 10 100 10 100 Wavelength (µm) Wavelength (µm)

安定化のメカニズムとして、カット・オフ面の変調による効果を提案する。

3. モデル

カット・オフ面との距離の違いにより、 山の部分で圧力が増大し、成長が抑制される。



谷の部分では、 ・カット・オフ面との距離が長い

### 山の部分では、

・カット・オフ面との距離が、谷の部分に比べて 短くなるので、局所的に圧力が増大

#### 3. カット・オフ面の変調

カット・オフ面の変調により、圧力が増大する。

レーザー吸収面が、アブレーション流によって変調させられる



### 3. カット・オフ面の変調

2Dシミュレーション "RAICHO" の結果より、 カット・オフ面が変調しているのが分かる。

"RAICHO"

N. Ohnishi et al.,

### 2D simulation "RAICHO"

Simulation condition (w/o radiation) Laser : I = 7 × 10<sup>13</sup> W/cm<sup>2</sup>,  $\lambda_L$  = 0.53 µm Target : CH 16 µm<sup>t</sup> :  $\lambda$  = 100 µm, a<sub>0</sub> = 0.5 µm

### 電子密度の等高線(*t* = 1 ns)



" カット・オフ面近傍 " 100 80 Laser Space (µm) 60 カット・オフ面 40 20 0 55 65 70 60 75 Position (µm) カット・オフ面は、アブレーション面の擾乱に 対して逆位相に変調していることが分かる。

J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transf. 71, 551 (2001) .

#### 3. 密度変調の分布

レイリー・テイラー不安定性に対する変調による成長の抑制は、 中波長領域 ( $\lambda$  = 30-120  $\mu$ m) で起こる。

密度の等高線の振幅( $\lambda = 100 \mu m, a_0 = 0.5 \mu m$ )



- ●密度の等高線の振幅は、振動減衰している。
- ●擾乱の半波長程度の距離で、反転した 振幅が最大になる。
- *U*λ=0.2-0.8, つまり、カット・オフ面での 振幅が反転する領域においてのみ、 圧力が増大する。

#### 3. 密度変調によるレーザー収束

入射レーザー光の収束効果によるRT成長抑制効果



カット・オフ面の変調による抑制効果
 レーザー収束効果による抑制効果
 ↓↓↓
 圧力をさらに増大させる効果!

### 3. 密度変調による抑制効果

レーザーの収束効果は、中波長領域の成長を抑制することを示唆



## まとめ

1. レイリー・テイラー不安定性の分散関係を計測した。特に、 短波長領域(12μm以下)はモアレ干渉法を導入し、計測した。

結果:a) アブレーションによる抑制効果が確認された。

b) 中波長領域では新たな成長抑制が発見された。

**2**. レイリー・テイラー不安定性の成長抑制の係数βを実験的に評価した。

結果:a)  $\beta$  = 2.0 for 20  $\mu$ m,  $\beta$  = 4.8 for 50  $\mu$ m.

**b)**  $\beta$ には波長依存性があることがわかった。

3. 中波長領域(50µm近傍)の成長率の低下に対して、カット・オフ面近傍での密度擾乱による抑制機構を提案した。

結果:カット・オフ面の変調により、

中波長領域のみ成長が抑制されることが示唆された。

3. レーザー収束効果

### レーザーの収束効果のモデル計算

屈折率

$$N(y) = \sqrt{1 - \frac{n_e(y)}{n_c}}$$
 (n<sub>e</sub>:電子密度 n<sub>c</sub>:カット・オフ密度)

屈折角: 
$$d\theta \approx \frac{dz}{dy} N(y) \left[ \frac{1}{N(y+dy)} - \frac{1}{N(y)} \right]$$
  
屈折長:  $l = \int_{\infty}^{z} dz \cdot \int_{0}^{\theta} d\theta$ 

ある界面(z=d)での電子密度擾乱振幅  $\delta n_e$  は、

$$\delta n_e \approx \frac{n_c e^{-d/L_0}}{L_0} \cdot f(z) \cdot \xi$$

 $(\xi: 擾乱振幅, L_0: 密度スケール長, f(z): 変調分布関数)$ 

レーザーの収束効果は、

 $l/\lambda \ll 1$ 

$$\frac{\delta I}{I} \approx \frac{4l}{\lambda} = \frac{k^2 L_c}{\pi L_0} \xi \int_{\infty}^{Cut-off} e^{-\frac{z}{L_0}} f(z) dz$$



#### 3. ダイナミック・オーバープレッシャーの増大

### 密度変調の発生によるRT成長の抑制効果



3. 考察

密度変調による抑制効果を増大させるメカニズム

1. 入射レーザーの自己収束効果 (*&I/I*の増大)

→ レーザー強度の非一様が増す

2. 磁場による効果 (*ε* < 1)

→ レーザーの非一様の減衰が抑制される(増大する可能性も)





Nishiguchi, A. 2002, Jpn. J. Appl. Phys. 41, 326.